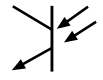
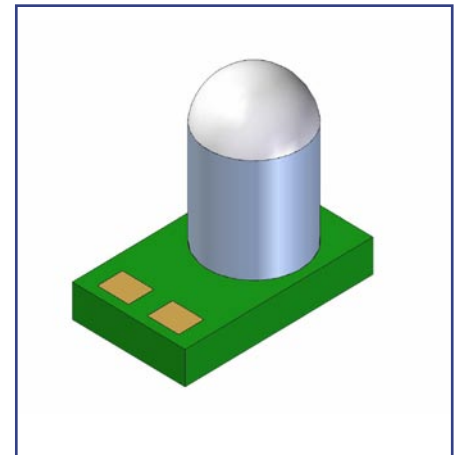


Si-NPN-Fototransistor Typ FT-30



MERKMALE

- ▶ Integrierte, abgestimmte Hochleistungsoptik
- ▶ Keine zusätzlichen Linsen erforderlich
- ▶ Extrem kleine Empfangs- und Schielwinkel
- ▶ 3mm-Bauform, Metallgehäuse
- ▶ Löt pads für Kabelanschluss



ANWENDUNG

- ▶ Für optische Sensoren

▶ ELEKTRISCHE DATEN

Parameter	Testbedingung	typ. Werte	Einheit
Dunkelstrom I_{ceo}	$V_{ce}=20V ; H=0mW/cm^2$	< 100	nA
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung V_{cesat}	$I_c=2mA ; I_b= 100\mu A$	<0,3	V
Kollektor-Emitter-Durchbruch (U_{ceo})	$I_c=100\mu A ; I_b=0$	>60	V
Spektrale Fotoempfindlichkeit	650nm	95	A/W
	875nm	148	
	940nm	95	
Emitter-Kollektor- Durchbruch (V_{eco})	$I_e=100\mu A ; I_b=0$	>5	V
Versorgungsspannung		+0....+30	V

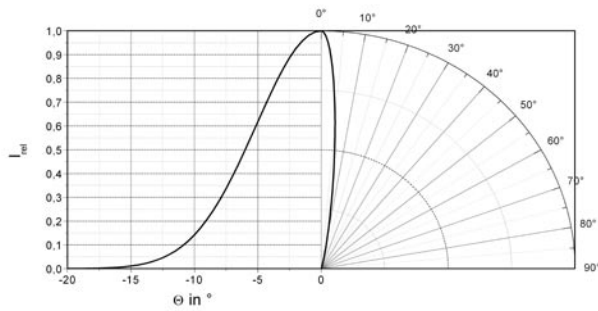
▶ TYPISCHE WERTE

Parameter	Testbedingung	typ. Werte	Einheit
Nutzbarer Wellenlängenbereich		400-1000	nm
Ansprechzeit	$10\%-90\% ; I_c=1mA, V_{ce}=5V ; R_l=1k\Omega$	t_r	15
		t_f	15
Bestrahlungsempfindliche Fläche (A)		0,11	mm ²
Empfangswinkel (θ)		6	Grad

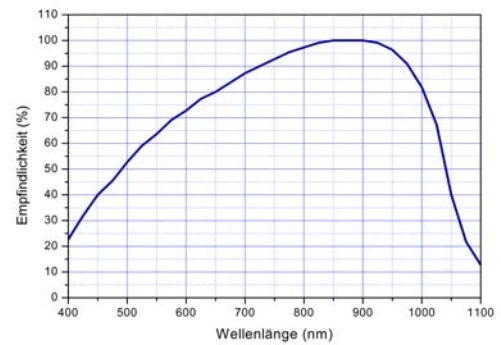


Si-NPN-Fototransistor Typ FT-30

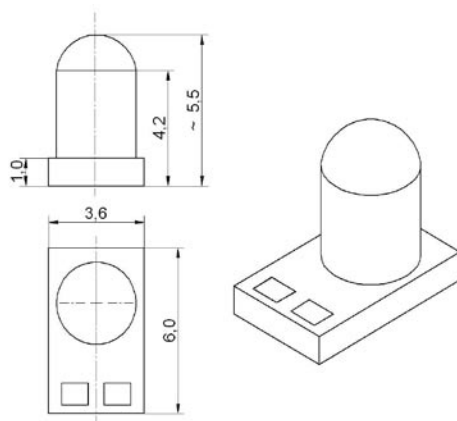
▶ DIAGRAMME

EMPFANGSCHARAKTERISTIK: $I_{rel} = f(\theta)$ 

RELATIVE SPEKTRALE EMPFINDLICHKEIT

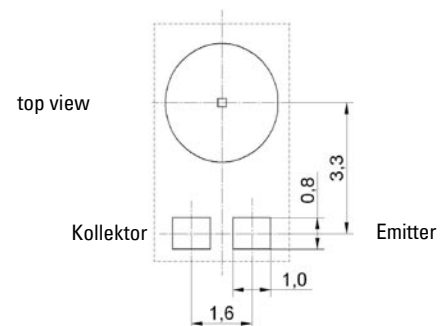


▶ ABMESSUNGEN GEHÄUSE



▶ ANSCHLÜSSE

Pad-Geometrie



BESTELLBEZEICHNUNG

OE-FT-30-VA1-SL10-2-0120